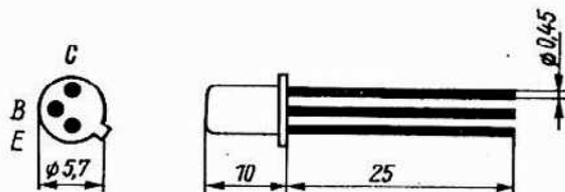


Transistoren
Транзисторы
Transistors

Ge-pnp-NF-Transistoren
Германиевые низкочастотные транзисторы типа p-n-p
p-n-p AF Ge-transistors

Typ	Grenzdaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$						Informationsdaten ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$)							
	P_{tot}	$-U_{\text{CBO}}$	$-U_{\text{CER}}$ $-U_{\text{CES}}^*$	bei			bei				bei			
				R_{BE}	$-U_{\text{EBO}}$	$-I_{\text{C}}$	$h_{21\text{E}}$ $h_{21\text{e}}^*$	$-U_{\text{CE}}$	$-I_{\text{C}}$	f_{T} $f_{h_{21\text{e}}^*}$	F	$-I_{\text{C}}$	f	$-I_{\text{CBO}}$
mW	V	V	k Ω	V	mA	V	mA	MHz	dB	mA	kHz	μA	V	
GC 100	50	15			10	15	18...224*6	2	>1	<25	0,2	1	<15	6
GC 101	50	15			10	15	18...224*6	2	>1	<10	0,2	1	<15	6
GC 112	50	80	80*		10	150	10...80*6	2	>0,3				<10	6
GC 116	150	20	20	1	10	150	28...224*6	2	>0,5	<20	0,3	1	<18	15
GC 117	150	25	20	1	10	150	45...224*6	2	>1,2	<10	0,3	1	<18	15
GC 118	150	25	20	1	10	150	45...224*6	2	>1,2	<5	0,3	1	<18	15
GC 121	150	25	20	1	10	250	28...224 0,5	100	0,012				<18	15
GC 122	150	35	33	1	15	250	18...140 0,5	100	0,012				<18	15
GC 123	150	70	66	1	15	250	18...140 0,5	100	0,012				<18	15
GC 301	180 1200 ¹⁾	32	32	0,5	10	1000	18...224 1	350	0,01*				<20	6

1) $\vartheta_{\text{C}} = 25^\circ\text{C}$



GC 100 ... GC 123
GC 301
GF 100, GF 105

Kurzz e i c h e n

A	wirksame Fläche	I_Z	Z-Strom	U_{CESat}	Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
C_c	Gehäusekapazität	ΔI_Z	Stabilität des Z-Stroms	U_{CEV}	Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei in Sperrichtung vorgepannter Emitterdiode
C_{gss}	Eingangskapazität	I_O	Ausgangsstrom	U_D	Blockierspannung
C_j	Sperrschichtkapazität	I_{O_0}	Richtstrom	U_{DB}	Drain-Bulk-Spannung
C_L	Lastkapazität	ΔI_{O_0}	Richtstromdifferenz	U_{DG}	Drain-Gate-Spannung
C_{tot}	Gesamtkapazität	l	Länge	U_{DM}	Scheitelblockierspannung
CMR	Gleichtaktunterdrückung	L	Leuchtdichte	\hat{U}_{DR}	Periodische Spitzenspannung
$d_{\dot{u}}$	Übertragungsdämpfung	L_S	Serieninduktivität	\hat{U}_{DS}	Nichtperiodische Spitzenspannung
E	Beleuchtungsstärke	N_O	Ausgangslastfaktor	U_{DS}	Drain-Source-Spannung
F	Rauschfaktor	P_{in}	HF-Eingangsleistung	U_e	Eingangsspannung
f	Frequenz	\hat{P}_{RS}	Nichtperiodische Sperrverlustleistung	U_{EBO}	Emitter-Basis-Sperrspannung
f_{h21b}	Grenzfrequenz in Basisschaltung	P_{tot}	Totale Verlustleistung	U_F	Durchlaßgleichspannung
f_{h21e}	Grenzfrequenz in Emitterschaltung	$R_{\dot{a}q}$	Äquivalentwiderstand	U_{GB}	Gate-Bulk-Spannung
f_Q	Gütegrenzfrequenz	R_{BE}	Basis-Emitter-Widerstand	U_{GS}	Gate-Source-Spannung
f_T	Transitgrenzfrequenz	R_{DS}	Drain-Source-Widerstand	U_{GT}	Zündspannung
G_{pb}	HF-Leistungsverstärkung in Basisschaltung	R_e	Eingangswiderstand	U_{HF}	HF-Spannung
h	Höhe	R_g	Generatorwiderstand	U_I	Gleichtakteingangsspannung
h_{21E}	Gleichstromverstärkung	R_L	Lastwiderstand	U_{ID}	Differenzeingangsspannung
h_{21e}	Kurzschlußstromverstärkung in Emitterschaltung	R_{th}	Gesamtwärmewiderstand	U_{IO}	Eingangsoffsetspannung
I_B	Basisstrom	R_{thi}	Innerer Wärmewiderstand	U_R	Sperrspannung, Sperrgleichspannung
I_C	Kollektorstrom	r_F	Durchlaßwiderstand	U_{RM}	Scheitelsperrspannung
I_{CBO}	Kollektorreststrom bei offenem Emitter	r_R	Sperrwiderstand	\hat{U}_{RR}	Periodische Spitzensperrspannung
I_{CES}	Kollektor-Emitter-Reststrom	r_Z	Z-Widerstand	\hat{U}_{RS}	Nichtperiodische Spitzensperrspannung
I_{CEV}	Kollektorreststrom bei in Sperrichtung vorgepannter Emitterdiode	S	Empfindlichkeit	U_S	Betriebsspannung
I_D	Drainstrom	t_{DHL}	Einschaltverzögerungszeit	U_{SB}	Source-Bulk-Spannung
I_{D_0}	Blockierstrom	t_{DLH}	Ausschaltverzögerungszeit	U_T	Schwellspannung
\hat{I}_{DR}	Drainspitzenstrom	t_{gt}	Zündzeit	U_Z	Z-Spannung
I_e	Strahlstärke	t_{off}	Ausschaltzeit	ΔU_Z	Stabilität der Z-Spannung
I_F	Flußstrom, Durchlaßgleichstrom	t_{on}	Einschaltzeit	U_{OH}	High-Ausgangsspannung
\bar{I}_F	Dauergrenzstrom	t_q	Freiwerdezeit	U_{OL}	Low-Ausgangsspannung
\hat{I}_F	Effektiver Durchlaßstrom	t_r	Anstiegzeit	V_U	Spannungsverstärkung
I_{FM}	Scheiteldurchlaßstrom	t_{rr}	Sperrerrholungszeit	Y_{21}	Steilheit
I_{FN}	Nenndurchlaßstrom, Nenngleichstrom	t_s	Speicherzeit	θ_a	Umgebungstemperatur
\hat{I}_{FR}	Periodischer Spitzensstrom	TK_{UZ}	Temperaturkoeffizient der Z-Spannung	θ_c	Gehäusetemperatur
\hat{I}_{FS}	Nichtperiodischer Spitzensstrom	U_{AN}	Nennanschlußspannung (Effektivwert)	θ_j	Sperrschichttemperatur
I_{GT}	Zündstrom	U_{BE}	Basis-Emitter-Spannung	$\Delta\theta$	Temperaturdifferenz
I_H	Haltestrom	$U_{(BR)}$	Durchbruchspannung	λ	Emissionswellenlänge
I_I	Eingangsbiasstrom	U_{CB}	Kollektor-Basis-Spannung	λ_p	Wellenlänge maximaler Emission
I_{IO}	Eingangsoffsetstrom	U_{CBO}	Kollektor-Basis-Sperrspannung	$\Delta\lambda$	Spektrale Halbwertsbreite
I_R	Sperrstrom	U_{CE}	Kollektor-Emitter-Spannung	τ_i	Einschaltzeitkonstante
I_T	Durchlaßstrom	U_{CEO}	Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei offener Basis		
\bar{I}_T	Dauergrenzstrom	U_{CER}	Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei endlichem Basis-Emitter-Widerstand		
\hat{I}_T	Effektiver Durchlaßstrom	U_{CERest}	Kollektorrestspannung		
\hat{I}_{TR}	Periodischer Spitzensstrom	U_{CES}	Kollektorsperrspannung bei kurzgeschlossenem Emitterdiode		